

物質の構造と対称性がもたらす 電磁交差応答の最前線： マルチフェロイクスとスピントロニクス

日時：2019年4月26日（金）13:30～17:20

会場：早稲田大学 西早稲田キャンパス

55号館N棟1階 大会議室A

対象：学部生・大学院生・教職員（無料・申し込み不要）

講演

反強磁性正四角台塔系 $A(\text{TiO})\text{Cu}_4(\text{PO}_4)_4$, $A = \text{Ba}, \text{Sr}, \text{Pb}$
の磁化曲線と電気磁気効果

加藤康之（東京大学）

ノンコリニア反強磁性体における磁気スピンホール効果

木俣基（東北大学金属材料研究所）

分子キラリティ制御に基づくスピン偏極電流
の生成と外場制御

須田理行（分子科学研究所）

主旨

物質の特徴的な構造と対称性から生じる電気と磁気の交差応答は現代物性物理学の主要な研究分野の一つです。本セミナーでは、この分野で活躍する若手の理論・実験研究者をお呼びして、最近の進展についてお話をいただきます。特に、磁場印加により電気分極を生じるマルチフェロイクス物質ならびに電流を磁化の流れ（スピン流）へと変換するスピントロニクス機能を発現する物質について、無機物質から有機物質まで幅広くご紹介いただきます。

主催：早稲田大学高等研究所

お問い合わせ先：早稲田大学高等研究所 講師 中 惇

〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学9号館708, naka@aoni.waseda.jp